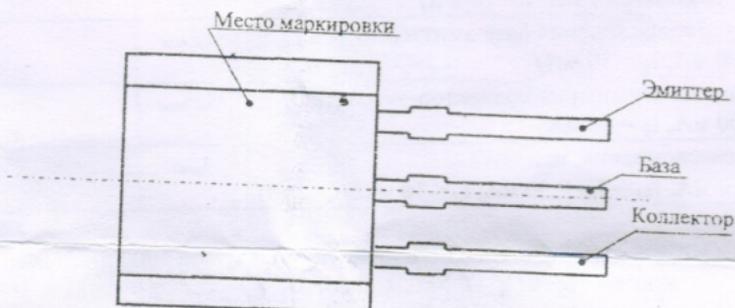




ТРАНЗИСТОР КТ3117А1

ЭТИКЕТКА

Кремниевый эпитаксиально-планарный п-р-п импульсный высокочастотный транзистор КТ3117А1 в пластмассовом корпусе, предназначенный для работы в оперативных и постоянных запоминающих устройствах и другой радиотехнической аппаратуре широкого применения.



Маркировка буквенно-цифровая с указанием типономинала транзистора без индекса «КТ», например: 3117А1

Масса не более 0,3 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{cp.} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мкА, ($U_{КБ} = 60 В$)	$I_{КБ0}$	-	10
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КБ} = 5 В, I_Э = 200 мА, f = 50 Гц$)	$h_{21Э}$	40	200
Емкость коллекторного перехода, пФ, ($U_{КБ} = 10 В, I_Э = 0, f = 10^7 Гц$)	C_K	-	10
Емкость эмиттерного перехода, пФ, ($U_{ЭБ} = 0, f = 10^7 Гц$)	$C_Э$	-	80
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, ($U_{КЭ} = 10 В, I_K = 30 мА, f = 10^8 Гц$)	$ h_{21Э} $	2,0	-
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, ($I_K = 500 мА, I_Б = 50 мА$)	$U_{Б^*нас}$	-	1,2
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($I_K = 500 мА, I_Б = 50 мА$)	$U_{К^*нас}$	-	0,6
Время рассасывания, нс, ($I_K = 500 мА, I_{Б1} = I_{Б2} = 50 мА, t_w \leq 30 мкс, Q \geq 50$)	$t_{рас}$	-	80

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ в 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:
Золото - 0,0475 г; Серебро - 0,2256 г

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ НА ВЫВОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа КТ3117А1 соответствуют техническим условиям аАО.336.262 ТУ.

Место для штампа ОТК 01К626

Место для штампа „Перепроверка произведена _____”

Место для штампа ОТК